
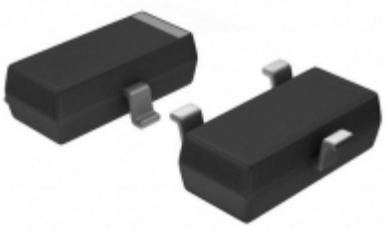

	<p><b>SI2304BDS-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI2304BDS-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT23-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI2304BDS-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 93081 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI2304BDS-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT23-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	93081 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	225pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


SI2304BDS-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI2304BDS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2304BDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2304BDS-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI2304(A69T)</b> Original SOT-23</p>	 <p><b>SI2304BDS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2304CDS-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY SOT23</p>	 <p><b>SI2304CDS-T1-E3</b> VISHAY VISHAY SOT-23</p>
 <p><b>SI2304BDS-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2304BDS-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2304-TP</b> Micro Commercial Components (MCC) N-CHANNEL MOSFET, SOT-23 PACKAGE</p>	 <p><b>SI2304BDS</b> VISHAY SI2304BDS VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

 SI2302WCB	 SI2303ADS-T1-GE3	 SI2303BDS	 SI2303BDS-T	 SI2303BDS-T1
 SI2303BDS-T1	 SI2303BDS-T1-E3	 SI2303BDS-T1-E3	 SI2303BDS-T1-GE3	 SI2303BDS-T1-GE3
 SI2303BDS/A5	 SI2303CDS	 SI2303CDS-T1-E3	 SI2303CDS-T1-E3	 SI2303CDS-T1-GE3
 SI2303CDS-T1-GE3	 SI2303DL-T1-E3	 SI2303DS	 SI2303DS-T1	 SI2303DS-T1-E3
 SI2303DS-T1-GE3	 SI2304-TP	 SI2304BDS-T1-E3	 SI2304BDS-T1-E3	 SI2304BDS-T1-GE3
 SI2304BDS-T1-E3	 SI2304DDS-T1-E3	 SI2304DDS-T1-GE3	 SI2304DDS-T1-GE3	 SI2304DS
 SI2304DS-T1	 SI2304DS-T1-E3	 SI2304DS-T1-GE3	 SI2305-CDS-T1-GE3	 SI2305ADS-T1-E3
 SI2305ADS-T1-E3	 SI2305ADS-T1-GE3	 SI2305ADS-T1-GE3	 SI2305BDS-T1-E3	 SI2305BDS-T1-GE3
 SI2305CDS-T1-E3	 SI2305CDS-T1-GE3	 SI2305CDS-T1-GE3	 SI2305DS	 SI2305DS-E3
 SI2305DS-T1	 SI2305DS-T1-E3	 SI2305DS-T1-E3	 SI2305DS-T1-GE3	 SI2305WCB

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited